СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОЙ СИСТЕМЫ HfZrCeYMgO, ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ

<u>В.А. БУЛАХ</u>, С. П. ЗЕНКИН

Национальный исследовательский Томский политехнический университет E-mail: vladabulakh@tpu.ru

Высокоэнтропийные керамические материалы имеют большие перспективы в области высокотемпературных защитных покрытий. Такие покрытия широко используются в авиастроительной промышленности, где требуется высокая термическая устойчивость [1]. Благодаря дополнительной энтропийной стабилизации кристаллической структуры четырех-и пятиэлементная высокоэнтропийная керамика обладает повышенными термическими и механическими свойствами. Термодинамическая стабильность этого твердого раствора определяется минимизацией свободной энергии Гиббса:

$$\Delta G_{mix} = \Delta H_{mix} - T \Delta S_{mix} \tag{1}$$

здесь ΔG_{mix} – свободная энергия Гиббса смешения, ΔH_{mix} – энтальпия смешения, ΔS_{mix} – энтропия смешения, T — абсолютная температура.

Энтропия системы описывается уравнением Больцмана:

$$\Delta S_{mix} = -R \sum_{i} c_i \ln(c_i) \tag{2}$$

здесь *R* – газовая постоянная, *c*_i – молярное содержание компонента.

Полученная свободная энергия Гиббса по уравнению (1) минимизируется увеличенной энтропией смешения со значением $\Delta S_{mix} = 1,61 R$ для пятикомпонентных материалов по сравнению с традиционными материалами, что дает дополнительную термодинамическую стабилизацию системы.

Рассматривались изменения оптических, механических и поверхностных свойств системы HfZrCeYO, а также системы с добавлением пятого компонента MgO - HfZrCeY(Mg)O.



Рисунок 1 - Диаграммы Эллингема наиболее термически стабильных оксидов с соответствующими температурами плавления (а), здесь сплошными линиями показаны выбранные оксиды, а пунктирными линиями — исключенные оксиды в данной работе;

(б) структуры выбранных компонентов оксидов в нормальных условиях и результирующая кристаллическая структура высокоэнтропийного оксида HfZrCeYO_{2-δ}

Для создания прочной прозрачной тонкопленочной керамики при подборе состава высокоэнтропийного оксида (ВЭО) использовалось сочетание трёх свойств материала: высокую температуру плавления оксида, наименьшую энтальпию образования (или минимальную свободную энергию Гиббса на единицу массы) и низкую электроотрицательность основного элемента. В результирующую группу выбранных оксидов были приняты HfO₂, ZrO₂, Y₂O₃, CeO₂, исключая радиоактивные ThO₂ и PuO₂ и токсичный BeO, рисунок 1а. С MgO была проведена дополнительная серия экспериментов. Введение

La₂O₃ в качестве пятого компонента может привести к образованию бинарных пирохлоровых структур типа Zr₂La₂O₇ и Hf₂La₂O₇ с пониженными температурами плавления.

Для системы HfO₂-ZrO₂-CeO₂ характерно положительное значение энтальпии смешения ($\Delta H_{mix} = +51,0 \pm 8,0 \text{ кДж/моль}$ для эквимолярного состава ZrO₂-CeO₂), что приводит к возможности фазового расслоения и сегрегация на области, богатые цирконием и церием, в отличие от системы HfO₂-ZrO₂-Y₂O₃, которая характеризуется $\Delta H_{mix} = 0$ (идеальный твердый раствор) для всех мольных соотношений. Полученный состав HEO HfZrCeYO_{2-δ} характеризуется значением энтропии $\Delta S_{mix} = 1,38R$ и простой кубической структурой Fm-3m, рисунок 1б.

Затем для сравнения свойств были приготовлены бинарные пленки Ce₃Y₄O₁₂ и HfZrO₄. Бинарные оксиды характеризуются кубической структурой для Ce₃Y₄O₁₂ и смешанной кубической + моноклинной структурой для HfZrO₄ без выделенной ориентации, рисунок 2а, синяя и оранжевая линии соответственно).

Кубическая структура Fm-3m HfZrCeYO_{2- δ} не распадается на отдельные моно- или бинарные оксиды в широком диапазоне молярных составов. Энергодисперсионная спектроскопия характерного состава пленки Hf₂Zr₂CeY₂O₁₃ показывает однородное распределение всех составляющих элементов без какой-либо локальной сегрегации элементов и фазового разделения на области, богатые Me, рисунок 2с.



Рисунок 2 - Рентгенограммы синтезированных пленок ВЭО (а); Спектральная зависимость коэффициента поглощения пленок ВЭО (б); СЭМ-вид сверху Hf₂Zr₂CeY₂O₁₃ и соответствующее EDS-картирование (с)

Однако описанные в литературе ВЭО на основе ZrO_2 и HfO₂ часто представляют собой «высокоэнтропийные», а не «энтропийно-стабилизированные» системы [2]. Обычно эти системы имеют нулевую энтальпию смешения $\Delta H_{mix} = 0$, что означает образование идеального твердого раствора без какой-либо дополнительной стабилизации. Типичным примером здесь являются системы HfO₂ – CeO₂ или ZrO₂ – CeO₂, где иттрий и церий сами выступают в роли стабилизаторов кубической решетки. Такая же ситуация имеет место и для систем $ZrO_2 - Y_2O_3$ или HfO₂ – Y₂O₃. Имеется несколько сообщений о высокоэнтропийной HfO₂ – ZrO₂ – Y₂O₃ – CeO₂ системе, которая кристаллизуется в твердый раствор с простой кубической структурой флюорита. Однако термические свойства этой системы еще не изучены. Кроме того, нет исследований о том, является ли эта система энтропийно-стабилизированной. Поэтому в данной серии экспериментов мы добавили MgO к HfO₂ – ZrO₂ – Y₂O₃ – CeO₂ с целью исследования этого эффекта.

Пленки НЕО были напылены с использованием двух несбалансированных магнетронов, оснащенных мишенями HfZr (50/50 ат. %) и CeY (33/66 ат. %). Концентрацию Mg контролировали добавлением Mg-дисков в зону эрозии CeY-магнетрона. Диаметр мишени

составлял 100 мм. Диаметр магниевого диска составлял 16 мм. Чистота всех использованных материалов составила 99,95 %.

Рентгенофазовый анализ синтезированных пленок представлен на рисунке 3. Пленка HfZrCeY(Mg)O с низкой концентрацией MgO 3,2 мол. % имеет ту же структуру, что и чистый HfZrCeYO.



Рисунок 3 - Рентгенограммы высокоэнтропийных пленок HfZrCeY(Mg)O в зависимости от молярной концентрации MgO

Дальнейшее увеличение концентрации MgO до 18,4 мол.% приводит к постепенному исчезновению пика (200) без каких-либо изменений взаимных интенсивностей других пиков, рисунок 3, синяя линия. При более высокой концентрации MgO (31,9 мол.%) можно обнаружить асимметрию пика (111), которая может быть обусловленна остаточными кристаллитами (200) или сегрегацией гекс-MgO (10-10) из единой кристаллической структуры, рисунок 3, желтая линия. При 34,5 мол. % MgO можно обнаружить только широкий пик при $2\theta = 31,02^{\circ}$, соответсвующий гекс-MgO (10-10), рисунок 3, зеленая линия. При дополнительном исчезновении пиков (220) и (311) это может быть следствием аморфизации пленки. Для всех синтезированных пленок не удалось обнаружить никаких других пиков, приписываемых тройным оксидным структурам (таким как Ce₂Hf₂O₇ или Y₂Zr₂O₇).

На основании измеренных данных можно сделать следующие выводы:

- 1) Система HfZrCeY(Mg)O образует твердый раствор простой кубической (Fm-3m) структуры без образования бинарных оксидов и отсутствия разделения фаз.
- Система HfZrCeY(Mg)O сохраняет единую ГЦК-кристаллическую структуру вплоть до концентрации MgO = 31,9 мол.%, если остальные входящие в ее состав оксиды взяты близкими к эквимолярному составу.
- Добавление MgO в близком к эквимолярному составу HfZrCeY(Mg)O повышает термические свойства ВЭО, но снижает механические свойства, такие как твердость и устойчивость к образованию трещин. Твердость близкого к эквимолярному HfZrCeY(Mg)O составила 18,2 ГПа.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 22-79-10069.

Список литературы

1. Zenkin S., Gaydaychuk A., Mitulinsky A., Linnik S. Tailoring of optical, mechanical and surface properties of high-entropy Hf-Zr-Ce-Y-O ceramic thin films prepared by HiPIMS sputtering // Surface and Coatings Technology. -2022. $-N_{2}433$.

2. Zenkin S., Gaydaychuk A., Mitulinsky A., Bulakh V., Linnik S Effect of the MgO Addition on the Structure and Physical Properties of the High Entropy HfZrCeYO Fluorite Ceramics // Coatings. -2023. - N13.